

ГЕРМАНИЕВЫЕ МИКРОМОДУЛЬНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ

ТМ-2А-3—ТМ-2Д-3 (p-n-p)

Конструктивное оформление — металлический герметизированный колпачок, устанавливаемый на микромодульной плате, с выводами, распаянными к пазам (рис. 233).

Вес 0,8 г.

Интервал рабочих температур от +73 до -60° С.

Допустимая относительная влажность окружающего воздуха 98% при температуре 40° С.

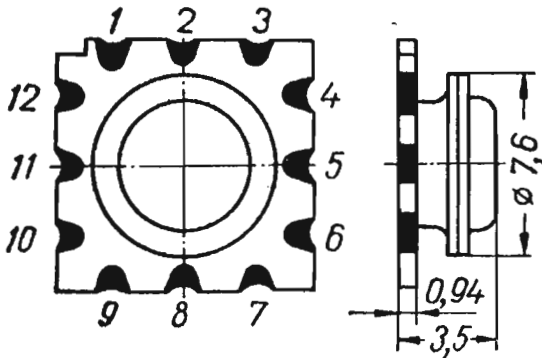
Интервал изменений атмосферного давления от 5 мм рт. ст. до 2 атм. Допускается применение транзисторов при атмосферном давлении до $1 \cdot 10^{-6}$ мм рт. ст.

Наибольшее постоянное ускорение 150 g.

Наибольшее ускорение при многократных ударах 150 g.

Наибольшее допустимое ускорение при вибрациях с частотами 5—2000 гц 10 g.

Рис. 233. Внешний вид и основные размеры микромодульных транзисторов.



Микротранзисторы монтируются на микромодульных платах размером $9,6 \times 9,6 \times 3,1$ мм и обозначаются буквами ТМ или М. Электроды транзисторов распаяваются по пазам микромодульной платы: 1 — база, 5 — эмиттер, 8 — коллектор.

Рабочее положение — любое.

Основное назначение — работа в аппаратуре широкого назначения с микромодульным исполнением.

Параметры транзисторов приведены в табл. 115.

Таблица 115

Параметры	Тип транзистора				
	ТМ-2А-3	ТМ-2Б-3	ТМ-2В-3	ТМ-2Г-3	ТМ-2Д-3
Предельная частота усиления по току, Мгц	3	3	9	9	20
Коэффициент усиления по току в схеме с общим эмиттером	20—120	50—250	30—250	70—400	80—450
Наибольшее напряжение на коллекторе в схеме с общей базой, в	-15	-15	-10	-10	-10
Наибольшая рассеиваемая мощность, мвт	75	75	75	75	75